# Single Diode

# Schottky Barrier Diode

D1FJ10						
10	0V 1A					
<b>持長</b>	Feature					
型SMD	<ul> <li>Small SMD</li> </ul>					
In= 0.2mA	• Low I <sub>R</sub> =0.2mA					

#### Main Use

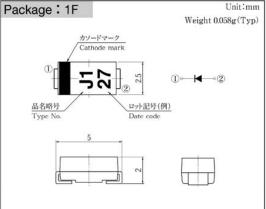
- ・スイッチング電源 • DC/DC コンバータ

. // • 低

用 途

- Switching Regulator DC/DC Converter ●家電、ゲーム、OA 機器 ● Home Appliance, Game, Office Automation
- 通信、ポータブル機器 Communication, Portable set

### ■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照 下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

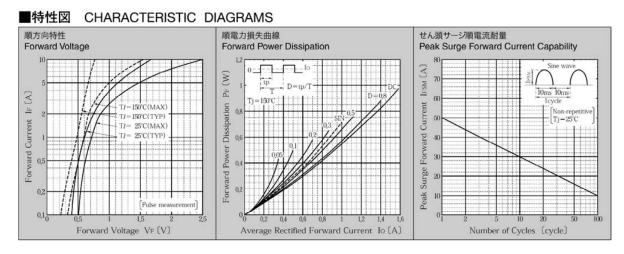
## ■定格表 RATINGS

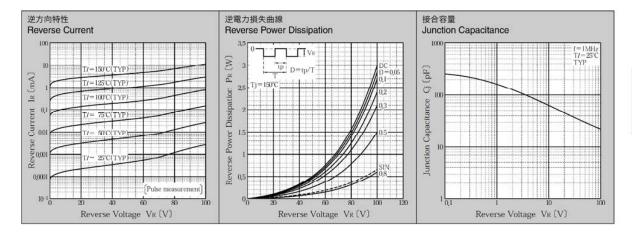
#### ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25℃)

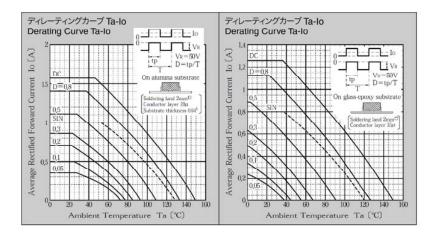
項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	品名 Type No.	D1FJ10	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			$-55 \sim 150$	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Тј			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			100	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	T	Io 50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Ta=52℃ アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.00	A
	10		Ta=36℃ プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.8	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃		50	А

#### ●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T1=25℃)

順電圧 Forward Voltage	VF	$I_F = 1.0 A$ , $\mathcal{N} \mathcal{N} \mathcal{X}$ Pulse r	測定 neasurement	MAX 0.72	V
逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R = V_{RM}$ , パルス測定 Pulse measurement		MAX 0.2	mA
接合容量 Junction Capacitance	Cj	$f = 1MHz, V_R = 10V$		TYP 63	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ j <i>l</i>	接合部・リード問 Junction to lead		MAX 23	
	0.	θ ja 接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX 108	°C/W
	Øja		プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	MAX 157	







- \* Sine waveは50Hzで測定しています。 \* 50Hz sine wave is used for measurements. \* 半導体製品の特性は一般的にバラッキを持っております。 Typicalは統計的な実力を表しています。 \* Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.